

## **KT503**

кремниевый биполярный эпитаксиально-планарный n-p-n транзистор

### Назначение

Кремниевые эпитаксиально-планарные биполярные транзисторы. Предназначены для использования в низкочастотных устройствах аппаратуры широкого применения.

# Зарубежный прототип

• Прототип KSC815

## Обозначение технических условий

• aAO, 336,183 ТУ / 02

# 123

## Особенности

- Диапазон рабочих температур от 45 до + 100°C
- Комплиментарная пара КТ502

# Корпусное исполнение

• пластмассовый корпус КТ-26 (ТО-92)

# Назначение выводов

| Вывод | Назначение |  |  |
|-------|------------|--|--|
| Nº1   | Эмиттер    |  |  |
| Nº2   | База       |  |  |
| Nº3   | Коллектор  |  |  |



Таблица 1. Основные электрические параметры КТ503 при Т<sub>окр. среды</sub> = 25 °C

| Параметры                             | Обозначение      | Ед. изм. | д. изм. Режимы измерения |       | Max |
|---------------------------------------|------------------|----------|--------------------------|-------|-----|
| Гр. напряжение коллектор-эмиттер      | Uкэо гр.         | В        | Iк=10mA, Iб=0            | 25-80 |     |
| Обратный ток коллектора               | Ікбо             | мкА      | Uкб= Uкб max             |       | 1   |
| Статический коэффициент передачи      | h <sub>21E</sub> |          | Uкэ=5B, Iк=10 мA         | 40    | 240 |
| тока                                  |                  |          |                          |       |     |
| Напряжение насыщения коллектор-       | Uкэ(нас)         | В        | Ік=10 мА, Іб=1 мА        |       | 0,6 |
| эмиттер                               |                  |          |                          |       |     |
| Напряжение насыщения база-эмиттер     | Uбэ(нас)*        | В        | Ік=10 мА, Іб=1 мА        |       | 1,2 |
| Граничная частота коэф. передачи тока | frp. *           | МГц      | Uкб= 5B, Iэ=-3 мА        | 5     |     |
| Емкость коллекторного перехода        | Ск *             | пФ       | Uкб= 5В, f=1МГц          |       | 50  |

<sup>\*</sup> Справочные параметры

Таблица 2. Значения предельно допустимых электрических режимов эксплуатации КТ503

| Параметры                           | Обозначение    | Ед. измер. | Значение |
|-------------------------------------|----------------|------------|----------|
| Напряжение коллектор-база           | <b>Окб</b> тах | В          | 40-100   |
| Напряжение коллектор-эмиттер        | Uкэ max        | В          | 25-80    |
| Напряжение эмиттер-база             | <b></b>        | В          | 5        |
| Постоянный ток коллектора           | Iк max         | мА         | 150      |
| Импульсный ток коллектора           | Іки тах        | мА         | 100      |
| $(tu \le 10 \text{ мс, } Q \ge 10)$ |                |            |          |
| Рассеиваемая мощность коллектора    | Рк тах         | мВт        | 300      |
| Температура перехода                | Tj             | °C         | 350      |

Таблица 3. Классификация КТ503

|            | KT503A | КТ503Б | KT503B | КТ503Г | КТ503Д | KT503E |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Uкб max, В | 40     | 40     | 60     | 60     | 80     | 100    |
| Uкэ max, B | 25     | 25     | 40     | 40     | 60     | 80     |
| Uкэо гр.   | 25     | 25     | 40     | 40     | 60     | 80     |
| h21e       | 40-120 | 80-240 | 40-120 | 80-240 | 40-120 | 40-120 |





# ОАО "ИНТЕГРАЛ", г. Минск, Республика Беларусь

Внимание! Данная техническая спецификация является ознакомительной и не может заменить собой учтенный экземпляр технических условий или этикетку на изделие.

ОАО "ИНТЕГРАЛ" сохраняет за собой право вносить изменения в описания технических характеристик изделий без предварительного уведомления.

Изображения корпусов приводятся для иллюстрации. Ссылки на зарубежные прототипы не подразумевают полного совпадения конструкции и/или технологии. Изделие ОАО "ИНТЕГРАЛ" чаще всего является ближайшим или функциональным аналогом.

Контактная информация предприятия доступна на сайте:

http://www.integral.by